

400-1100nm 高速型硅偏压光电探测器 150ps 窗片



产品描述

400-1100nm, 峰值波长 730nm, 感光尺寸 $\Phi 250\mu\text{m}$, 上升时间 150ps, 带宽 2GHz, 输入耦合方式为窗片

产品特点

感光范围覆盖 400nm~1100nm, 高速型, 偏压型探测器噪声极低, 响应快, 无增益, 成本低, 适用于常规光电探测应用, 性能卓越, 性价比高

产品型号

PDSBH2W

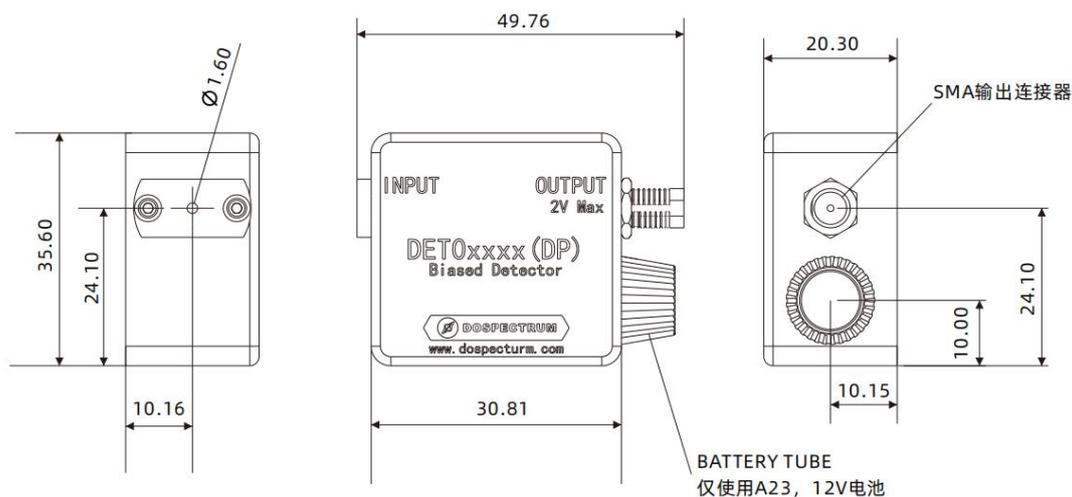
应用领域

可见光与红外光测

核心参数

材料	感光范围	感光尺寸	上升时间	输入耦合方式
硅	400-1100nm	Φ250um	150ps	窗片

尺寸图



通用参数

参数	值		
输入耦合方式	窗片	球透镜	FC/PC 光纤座
波长范围	400-1100nm, 峰值波长 730nm		
峰值响应	0.46A/W		
3dB 带宽 (@50 Ω)	2Ghz	2Ghz	1GHz
上升/下	150ps/150ps	150ps/150ps	1ns/1ns

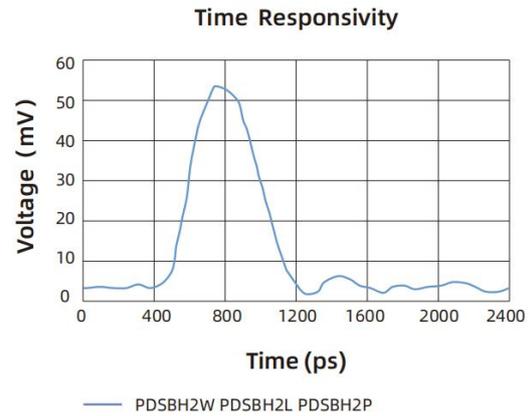
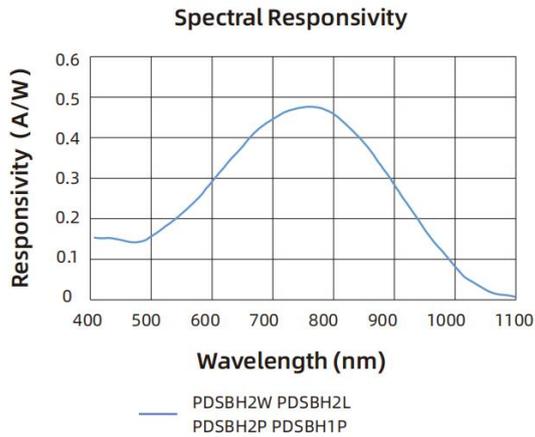
降时间 (@50 Ω)			
NEP	$9.29 \times 10^{-15} \text{W/Hz}^{1/2}$	$9.29 \times 10^{-15} \text{W/Hz}^{1/2}$	$9.5 \times 10^{-15} \text{W/Hz}^{1/2}$
暗电流	35pA	35pA	126pA
输出电压	2V(Max)	2V(Max)	3.3V(Max)
结电容	1.73pF		
偏置电压	12V		
输出电流	0~10mA		
工作阻抗	50Ω		
感光尺寸	Φ250um		
光敏面特 性	平面 增透 膜	透镜尺寸 0.059" (1.50 mm)	内嵌耦合透镜 0.059" (1.50mm)
探测器净 重	0.18kg		
工作温度 /存储温 度	0-40°C		
外观尺寸	2.21" X 1.4" X 0.80" (56.1 mm X 35.6 mm X 20.3mm)		
供电电池	信号接口	支杆接口	

A23, 12VDC,
40mAh

SMA (直流耦合)

M4×1

响应曲线



产品配置



(配件一: A23, 12V 电池)



(配件二: SMA-BNC 信号线)

可选配置表

硅偏压光电探测器		可选配置				
产品名称	材料	类型	特点	感光范围, 感光尺寸	带宽	输入耦合方式
PD: "光电探测器"	S: Si 硅 基	B: 偏压型	H: 高速型	4G025: 400-1100nm, Φ 250um	1: 1GHz 2: 2GHz	W: 窗片 L: 球透镜 P: FC/PC 光纤 座